2019

B.Sc.

1st Semester Examination

ELECTRONICS (General)

Paper: DSC 1A-T

Network analysis and Analog Electronics

Full Marks: 40

Time: 2 Hours

The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Group-A

1. Answer any five questions:

5×2=10

- (a) What are ' α ' and ' β ' of a transistor? 1+1
- (b) Why is base biasing is a poor way to bias a transistor in linear circuits?

[Turn Over]

(c) State the Barkhausen criterion for sustained

	oscillation.	2	-
(d)	Why is the intrinsic stand-off ratio of UJT than unity?	less 2	
(e)	State Maximum power transfer theorem.	2	
(f)	What is the thermal runaway of a transistor		
(g)	Define percentage voltage regulation factor of rectifier and mention its physical significance.		
(h)	What is regenerative feedback? Why it is called?	so +1	2
	Group-B		
Answer any four questions: 4×5		×5	
(a)	What is Q-point of a transistor? Mention factors responsible for the stability of Q-point 2		
(b)	Derive the relation between transconductance	g _m	

5

and drain current I_0 of a JFET.

- (c) Draw the circuit diagram of a full-wave rectifier and explain the principle of operation. 2+3
- (d) Explain different current components in a p-n-p transistor when the emitter junction is forward-biased and the collector junction is reversed-baised.
- (e) State and prove the Thevenin's theorem. 2+3
- (f) Derive the barrier width in a p-n junction diode.

Group-C

3. Answer any one question:

- 1×10
- (a) Distinguish between Zener breakdown and avalanche breakdown. Explain the working principle of regulated power supply using Zener diode.

 4+6
- (b) What do you mean by rectification of a.c input signal? Discuss the operation of a full-wave bridge rectifier circuit. What are line and load regulations. 2+5+(1½+1½)

*

বঙ্গানুবাদ

বিভাগ-ক

		NO DECIMINA INC. IN	
۱ د	্যে-(কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :	৫×২
	(ক)	ট্রানজিস্টারের 'আল্ফা' ও 'বিটা' কি?	2+2
	(খ)	রৈখিক বা একঘাত বর্তনীগুলির ট্রানজিস্টার বায়ানি	সং-এর
		ক্ষেত্রে ভূমিগত বায়াসিং কেন নিম্নমানের হয়?	২
	(গ)	সাস্টেইন্ড বা টেকসই দোলনার ক্ষেত্রে বার্কছসেন নি	ৰ্গায়কটি
		বিবৃত কর।	২
	(ঘ)	UJT-র ক্ষেত্রে ইন্ট্রিন্সিক স্ট্যান্ড-অফ্ অনুপাতটি	একের
		থেকে কম হয় কেন?	২
	(8)	সর্বাধিক ক্ষমতা হস্তান্তরের উপপাদ্যটি বিবৃত কর।	ঽ
	(<u>p</u>)	ট্রান্জিস্টারের তাপীয় পলায়ন (thermal runaway)) কি?
			২
	(ছ)	একমুখীকারির পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন ফ্যার্ট্ট	র-এর
		সংজ্ঞা লেখ এবং এর বাস্তব গুরুত্ব উল্লেখ কর।	
	(জ)	পুনরুত্থানকারী প্রতিক্রিয়া কি? এটিকে এরকম বল	া হয়
		কেন?	\ _\

বিভাগ-খ

|--|

- (क) ট্রান্জিস্টারের Q-বিন্দু কি? Q-বিন্দুর স্থিতিশীলতার জন্য দায়িত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উল্লেখ কর। ২+৩
- (খ) একটি JFET-এর ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স, $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$ এবং ড্রেইন কারেন্ট $\mathbf{I}_{\mathbf{D}}$ -এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করো।
- (গ) পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকারির বর্তনীচিত্র আঁকো এবং কার্যনীতি
 বর্ণনা কর।
- (घ) p-n-p ট্রান্জিস্টারের বিভিন্ন কারেন্ট কম্পোনেন্টগুলি ব্যাখ্যা
 কর, যখন নিঃসারক সংযোগটি ফরোয়ার্ড বায়াসে ও সংগ্রাহক
 সংযোগটি রিভার্সড্-বায়াসে থাকবে।
- (%) থেভেনিন-এর উপপাদ্যটি বিবৃত কর ও প্রমাণ কর। ২+৩
- (চ) p-n junction ডায়োডের ক্ষেত্রে বাধাপ্রস্থ বের কর। ৫

বিভাগ-গ

- ৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির থেকে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 - (ক) জেনার ব্রেকডাউন ও আভালাঞ্চ ব্রেকডাউনের প্রভেদ কর। জেনার ডায়োড ব্যবহার হচ্ছে, এমন রেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।
 8+৬

[Turn Over]

8×¢

(খ) এ.সি. ইনপুট সিগ্ন্যালের রেক্টিফিকেশন্ বলতে তুমি কি বোঝোং পূর্ণতরঙ্গ ব্রীজ রেক্টিফায়ার (একমুখীকারির) এর সার্কিটের কার্যনীতি বর্ণনা কর। লাইন এবং লোড রেগুলেশন কিং ২+৫+(১ \frac{5}{5}+5 \frac{5}{5})